









|   |   |
|---|---|
|  | <p><b>SI3459BDV-T1-E3</b></p>   |
|   | <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI3459BDV-T1-E3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 60V 2.9A 6-TSOP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  SI3459BDV-T1-E3.pdf</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 144645 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>                |   |

Spezifikationen

|  |  |
|--|--|
| Teilenummer                                      | SI3459BDV-T1-E3                                    |
| Hersteller                                       | Electro-Films (EFI) / Vishay                       |
| Beschreibung                                     | MOSFET P-CH 60V 2.9A 6-TSOP                        |
| Kategorie  | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,   |
| Teilstatus                                       | 144645 pcs Stock                                   |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit                  | 33 Weeks   |
| detaillierte Beschreibung                        | P-Channel 60V 2.9A (Tc) 2W (Ta), 3.3W (Tc) Surface |
| Serie  | TrenchFET®   |
| Technologie                                      | MOSFET (Metal Oxide)                               |
| Betriebstemperatur                               | -55°C ~ 150°C (TJ)                                 |
| Befestigungsart                                  | Surface Mount                                      |
| Verpackung / Gehäuse                             | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6                           |
| Supplier Device-Gehäuse                          | 6-TSOP   |
| Verlustleistung (max)                            | 2W (Ta), 3.3W (Tc)                                 |
| Typ FET  | P-Channel  |
| FET-Merkmal                                      | -  |
| Drain-Source-Spannung (Vdss)                     | 60V  |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 2.9A (Tc)  |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs                           | 216 mOhm @ 2.2A, 10V                               |
| VGS (th) (Max) @ Id                              | 3V @ 250µA   |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs                     | 12nC @ 10V   |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds              | 350pF @ 30V  |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)        | 4.5V, 10V  |
| Vgs (Max)  | ±20V   |
| Verpackung                                       | Tape & Reel (TR)                                   |
| Bleifreier Status / RoHS-Status                  | Lead free / RoHS Compliant                         |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)        | 1 (Unlimited)                                      |
| Andere Namen                                     | SI3459BDV-T1-E3-ND                                 |

SI3459BDV-T1-E3 ist neu im Original. Suche SI3459BDV-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3459BDV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3459BDV-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  <p><b>SI3459BDV-T1-E3</b><br/>Vishay / Siliconix<br/>MOSFET P-CH 60V 2.9A 6-TSOP</p> |  <p><b>SI3459BDV-T1-GE3</b><br/>Vishay / Siliconix<br/>MOSFET P-CH 60V 2.9A 6-TSOP</p> |  <p><b>SI3459DV-T1</b><br/>VISHAY<br/>SI3459DV-T1 VISHAY</p>         |  <p><b>SI3459-KIT</b><br/>Energy Micro (Silicon Labs)<br/>EVAL KIT FOR SI3459 POE CTRLR</p>      |
|  <p><b>SI3458DV-T1-GE3</b><br/>VISHAY<br/>SI3458DV-T1-GE3 VISHAY</p>                  |  <p><b>SI3459BDV-T1-E</b><br/>VISHAY<br/>SI3459BDV-T1-E VISHAY</p>                     |  <p><b>SI3459BDY-T1-E3</b><br/>VISHAY<br/>SI3459BDY-T1-E3 VISHAY</p> |  <p><b>SI3459-B02-IM</b><br/>Energy Micro (Silicon Labs)<br/>IC POE PSE 8 PORT 802.3AT 56QFN</p> |

heiße Teile

Mehr

- |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ⚙ SI3457-B02-IT    | ➔ SI3457BDV        | ➔ SI3457BDV-T1     | D SI3457BDV-T1-E3  | ➔ SI3457BDV-T1-E3  |
| ⊣ SI3457BDV-T1-GE3 | ⚙ SI3457BDV-T1-GE3 | D SI3457CDV-T1-E3  | ➔ SI3457CDV-T1-E3  | ➔ SI3457CDV-T1-GE3 |
| ⚙ SI3457CDV-T1-GE3 | ⊣ SI3457DV         | ⚙ SI3457DV         | ➔ SI3457DV-T1      | ➔ SI3457DV-T1-E3   |
| D SI3457DV-T1-GE3  | ⚙ SI3457DV-T1-E3   | ⊣ SI3458BDV-T1-E3  | ⚙ SI3458BDV-T1-E3  | ➔ SI3458BDV-T1-GE3 |
| ➔ SI3458BDV-T1-GE3 | ➔ SI3458DV-T1-E3   | ⚙ SI3458DV-T1-E3   | ⊣ SI3458DV-T1-GE3  | ➔ SI3459BDV-T1-E   |
| ➔ SI3459BDV-T1-E3  | ➔ SI3459BDV-T1-GE3 | D SI3459BDV-T1-GE3 | ⚙ SI3459DV-T1-E3   | ⊣ SI3459DV-T1-E3   |
| ⚙ SI3459DV-T1-GE3  | D SI3460-E02-GMR   | ➔ SI3460-E03-GMR   | ➔ SI3460BDV-T1-E3  | ➔ SI3460BDV-T1-E3  |
| ⊣ SI3460BDV-T1-GE3 | ⚙ SI3460BDV-T1-GE3 | ➔ SI3460DDV        | ➔ SI3460DDV-T1-GE3 | ➔ SI3460DDV-T1-GE3 |
| ⚙ SI3460DV         | ⊣ SI3460DV-T1      | ⚙ SI3460DV-T1-E3   | D SI3460DV-T1-E3   | ➔ SI3460DV-T1-GE3  |
| ➔ SI3460DV-T1-GE3  | ⚙ SI3461DV-T1-E3   | ⊣ SI3461DVT1-GE3   | ⚙ SI3464DV         | ➔ SI3464DV-T1-GE3  |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

